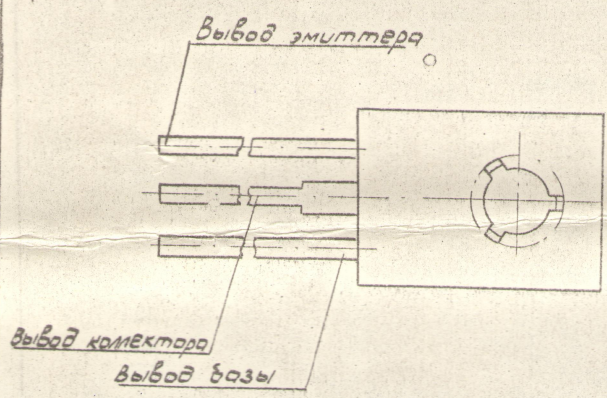


П309М

200

ЭТИКЕТКА

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ П307ВМ, П308М, П309М



Масса не более 1 г

Содержание драгметаллов в одном транзисторе
золото 4,6435 мг

ЭТИКЕТКА

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ t окр. ср. = $25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а		
		не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА при $R_{ЭБ} \leq 10\text{кОм}$ ($I_{КЭ} = 80\text{В}$ для П307ВМ $I_{КЭ} = 120\text{В}$ для П308М, П309М)	$I_{КЭВ}$		50	
Обратный ток коллектора, мкА ($I_{КБ} = 80\text{В}$ для П307ВМ $I_{КБ} = 120\text{В}$ для П308М, П309М)	$I_{КБВ}$		20	
Обратный ток эмиттера, мкА ($I_{ЭВ} = 3\text{В}$)	$I_{ЭВ}$		10	
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала ($I_{КБ} = 20\text{В}$, $I_{Э} = 10\text{мА}$)	$h_{21э}$			
		П307ВМ	50	150
		П308М	30	90
		П309М	16	60
Сопротивление насыщения в режиме малого сигнала, Ом ($I_{К} = 1\text{мА}$, $I_{Б} = 3\text{мА}$)	Σ $K_{нас}$			
		П307ВМ		250
		П308М		200
		П309М		150

20.10.81 1980

ШТАМП ОТ

ОТК 163

УПАКОВЩИК №3

Перепроверено 20.10.81

ОТК 163